

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
28 octobre 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/093202 A1**

(51) Classification internationale des brevets :  
H01L 31/18 31/0236

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCI/FR2004/050151

(22) Date de dépôt international : 9 avril 2004 (09.04.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
03/04676 14 avril 2003 (14.04.2003) FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :  
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3, Rue Michel Ange, F-75794 Paris  
Cedex 16 (FR). UNIVERSITE DE POITIERS [FR/FR];  
15, Rue de l'Hôte Dieu, F-86034 Poitiers Cedex (FR)

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : STRABONI,  
Alain [FR/FR]; 6, Rue Marcel Pagnol, F-86180 Buxerolles  
(FR)

(74) Mandataire : DE BEAUMONT, Michel; Cabinet Michel  
De Beaumont, 1, Rue Champollion, F-38000 Grenoble  
(FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de  
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,  
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,  
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,  
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,  
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,  
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de  
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM,  
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, IZ, UG, ZM, ZW); eurasien  
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM); européen (AT,  
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,  
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR);  
OAPI (BF, BI, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, IG).

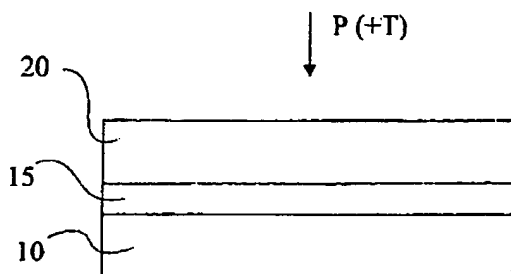
**Publiée :**

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des  
revendications sera republiée si des modifications sont re-  
çues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-  
tions, se référer aux 'Notes explicatives relatives aux codes et  
abréviations' figurant au début de chaque numéro ordinaire de  
la Gazette du PCT.

(54) Titre: SINTERED SEMICONDUCTOR MATERIAL

(54) Titre : MATERIAU SEMICONDUCTEUR OBTENU PAR FRITTAGE



(57) Abstract: The invention relates to a method for  
forming a semiconductor material obtained by sinter-  
ing powders and to a semiconductor material. The  
method comprises a compression and heat treatment  
stage such that one part of the powder is melted or be-  
comes viscous. The material can be used in the pho-  
tovoltaic field

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé  
de formation d'un matériau semiconducteur obtenu  
par frittage de poudres ainsi qu'un matériau  
semiconducteur. Le procédé comprend une étape de  
compression et de traitement thermique tel qu'une  
partie des poudres est fondue ou rendue visqueuse.

WO 2004/093202 A1

Le matériau est utilisable dans le domaine photovoltaïque